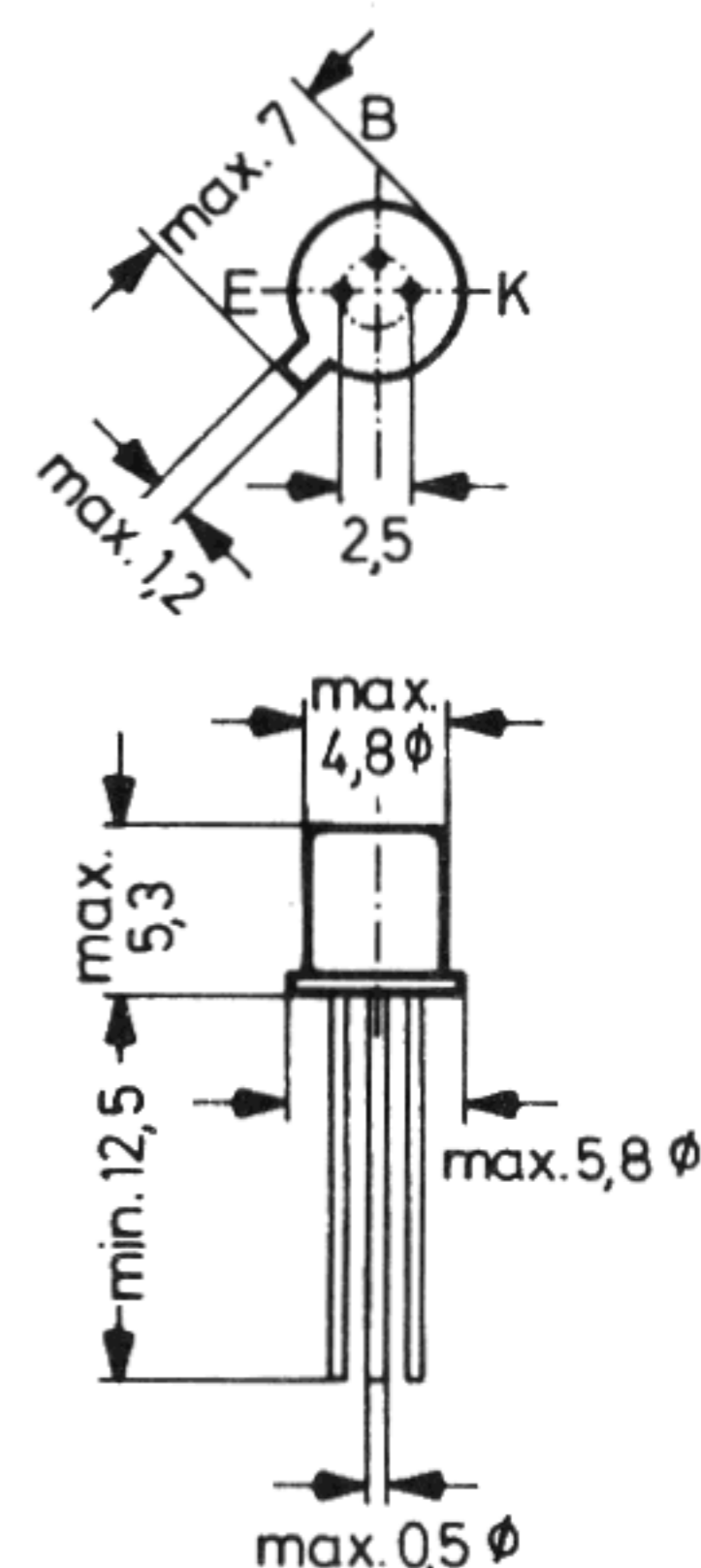


NPN-Silizium-Epitaxie-Planar-Transistor
 mit hoher Kollektor-Emitter-Spannung,
 geeignet als Treibertransistor
 für Zifferanzeige-Glimmröhren

www.datasheetcatalog.com

Metallgehäuse JEDEC TO-18
 18 A 3 nach DIN 41 876
 Gewicht ca. 0,35 g
 Kollektor mit Gehäuse verbunden
 Maße in mm



Grenzwerte

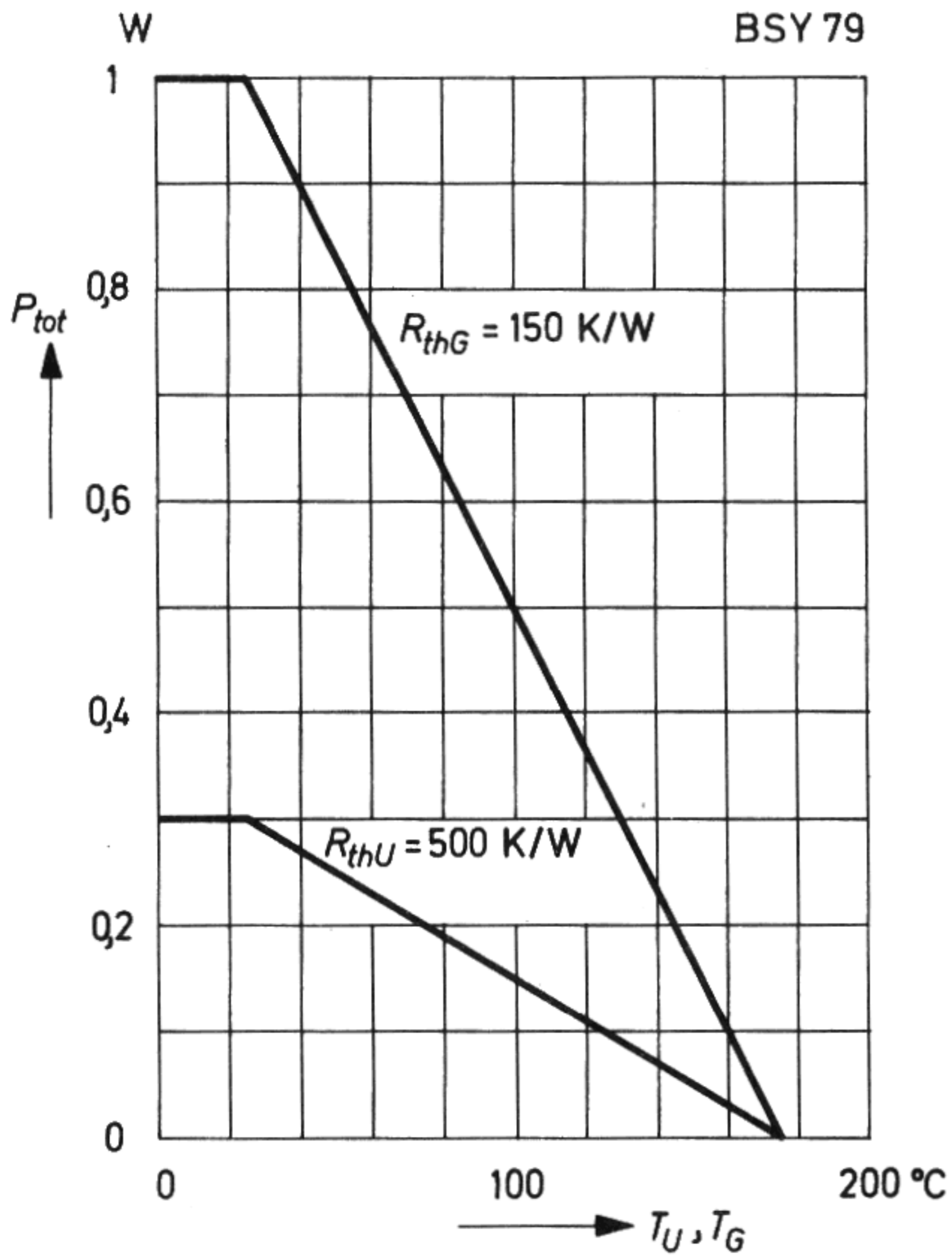
Kollektor-Basis-Spannung	U_{CB0}	120	V
Kollektor-Emitter-Spannung bei $U_{EB} = 1\text{ V}$	U_{CEV}	120	V
Emitter-Basis-Spannung	U_{EB0}	5	V
Kollektorstrom	I_C	30	mA
Verlustleistung bei $T_U = 25\text{ °C}$ bei $T_G = 25\text{ °C}$	P_{tot} P_{tot}	300 1	mW W
Sperrschichttemperatur	T_i	175	°C

Kennwerte bei $T_i = 25\text{ °C}$

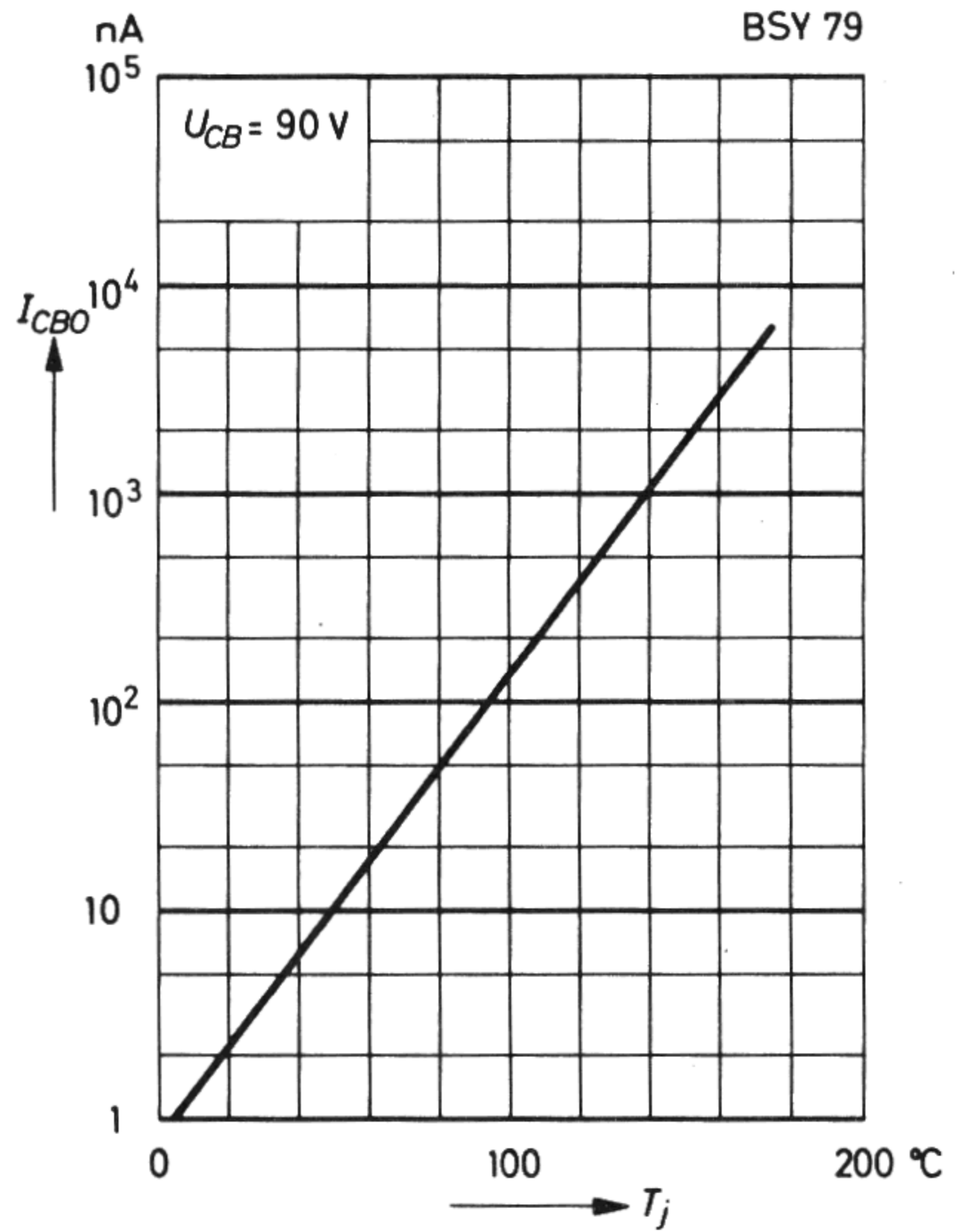
Kollektor-Basis-Stromverhältnis bei $U_{CE} = 1\text{ V}$, $I_C = 1\text{ mA}$	B_1	60 (> 30)	
Kollektor-Sättigungsspannung bei $I_C = 2\text{ mA}$, $I_B = 0,2\text{ mA}$	U_{CEsat}	0,3 (< 0,5)	V
Basis-Sättigungsspannung bei $I_C = 2\text{ mA}$, $I_B = 0,2\text{ mA}$	U_{BEsat}	< 1	V
Kollektorreststrom bei $U_{CB} = 90\text{ V}$, bei $U_{CB} = 90\text{ V}$, $T_U = 150\text{ °C}$	I_{CB0} I_{CB0}	3 (< 50) < 10	nA µA
Emitterreststrom bei $U_{EB} = 4\text{ V}$	I_{EB0}	2 (< 50)	nA
Kollektor-Basis-Kapazität bei $U_{CB} = 10\text{ V}$	C_{CB0}	4	pF
Emitter-Basis-Kapazität bei $U_{EB} = 0,5\text{ V}$	C_{EB0}	17	pF
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft Sperrschicht – Gehäuse	R_{thU} R_{thG}	< 500 < 150	K/W K/W
Transitfrequenz bei $U_{CE} = 10\text{ V}$, $I_C = 10\text{ mA}$, $f = 50\text{ MHz}$	f_T	100	MHz

zulässige Gesamtverlustleistung in Abhängigkeit von der Temperatur

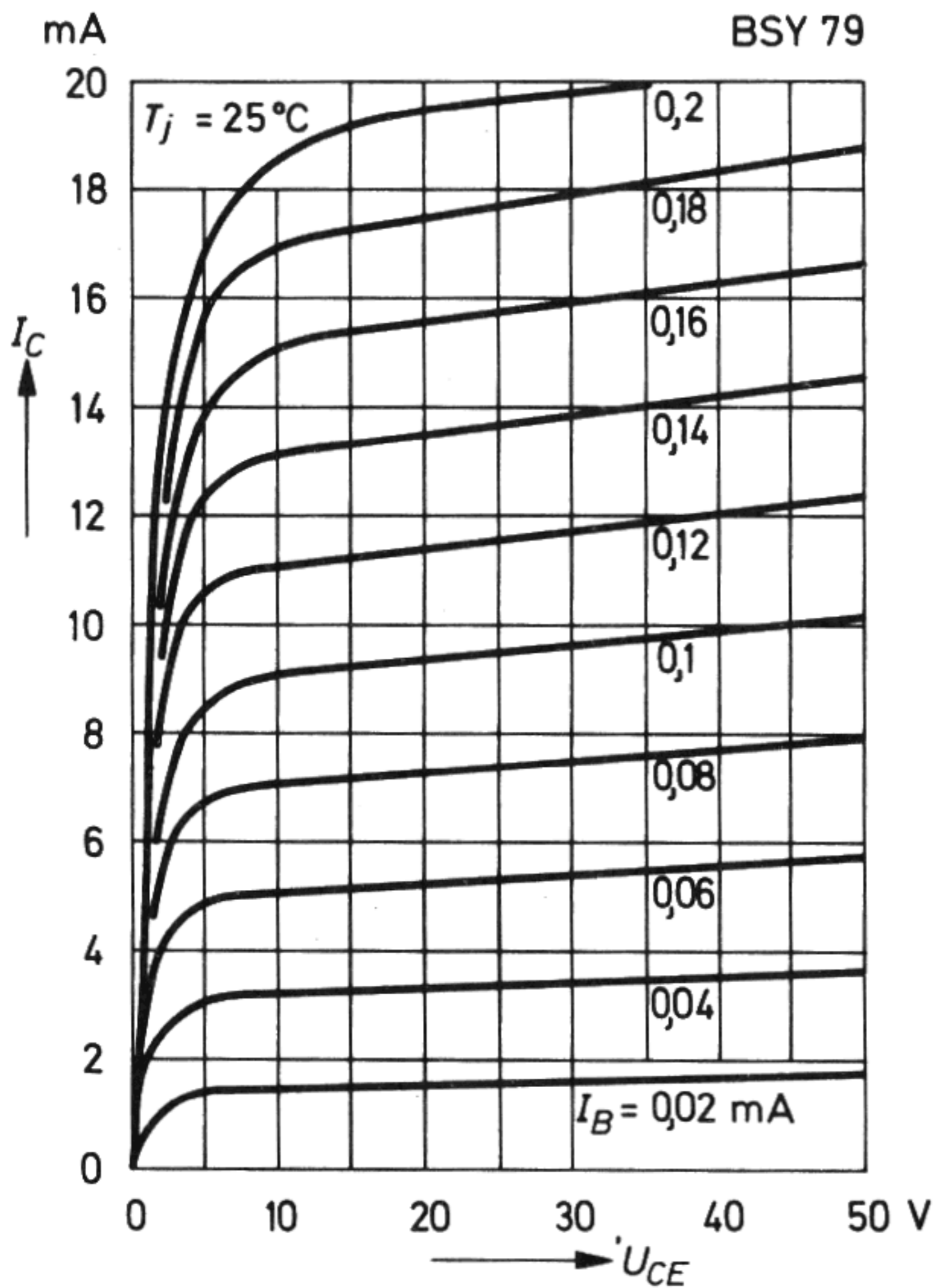
www.datasheetcatalog.com



Kollektorreststrom in Abhängigkeit von der Sperrschichttemperatur



Ausgangskennlinien Emitterschaltung



Kollektor-Basis-Stromverhältnis in Abhängigkeit vom Kollektorstrom

